Family list 2 family member for: JP9078059 Derived from 1 application.

1 ORGANIC THIN LAYER LIGHT-EMITTING ELEMENT Publication Info: JP363019182 B2 - 2005-03-16 JP9078059 A - 1997-03-25

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

ORGANIC THIN LAYER LIGHT-EMITTING ELEMENT

Patent number: JP9078059
Publication date: 1997-03-25

Inventor: YAMAZAKI MASASHI; SHIRAISHI YOTARO; KURODA

MASAMI; KAWAKAMI HARUO

Applicant: FUJI ELECTRIC CO LTD

Classification:

- international: C09K11/06; H05B33/14; H05B33/22; C09K11/06:

H05B33/14; H05B33/22; (IPC1-7): C09K11/06;

H05B33/14

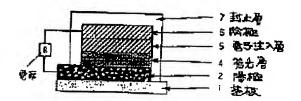
- european:

Application number: JP19950233663 19950912 Priority number(s): JP19950233663 19950912

Report a data error here

Abstract of JP9078059

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain an organic thin film light-emitting element for a variety of display devices excellent in mechanical and thermal stabilities and in electron injection properties without deterioration in continuous driving by admixing a specific thiazole to the electron-injecting layer or the luminescent layer. SOLUTION: Indium tin oxide(ITO) pattern is formed on the glass base plate 1 as an anode, the surface is washed, and the glass base plate is fitted to the base plate holder in the resistance-heating type vapor deposition apparatus. Then, the apparatus is evacuated into vacuum to bake the base plate at 150 deg.C, then the plate is cooled down to 50 deg.C to stabilize the temperature and the degree of vacuum and a diamine of formula I is heated with a resistance-heating type vaporizer to form the light-emitting layer 4. Subsequently, a thiazole of formula II (Ar<1> and Ar<2> are each an aryl or heterocyclic group which may be substituted) is similarly vaporized to form the electron injection layer 5, further MgIn alloy is vapor cometallized as a cathode 6. Finally, the multilayer product is sealed with a fluorine resin to form the seal layer 7 thereby giving the objective organic thin layer light-emitting element.



П

1

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-78059

(43)公開日 平成9年(1997)3月25日

(51) Int. Cl. 6

識別記号

FΙ

C09K 11/06

H05B 33/14

9280-4H

C09K 11/06

H05B 33/14

Z

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全12頁)

(21)出願番号

特願平7-233663

(22)出願日

平成7年(1995)9月12日

(71)出願人 000005234

富士電機株式会社

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号

(72)発明者 山崎 正志

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号

富士電機株式会社内

(72)発明者 白石 洋太郎

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号

富士電機株式会社内

(72)発明者 黒田 昌美

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号

富士電機株式会社内

(74)代理人 弁理士 山口 巖

最終頁に続く

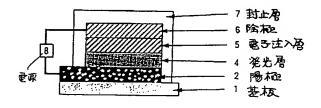
(54) 【発明の名称】有機薄膜発光素子

(57) 【要約】

【課題】薄膜の機械的熱的安定性および電子注入性が良 好で連続駆動時の劣化が少ない有機薄膜発光素子を得

【解決手段】一般式で示されるチアジアゾール系化合物 を電子注入層5または発光層4に含有させる。

【化12】



【特許請求の範囲】

【請求項1】下記一般式で表されるチアジアゾール系化 合物を電子注入層または発光層に含有することを特徴と する有機薄膜発光素子。

【化1】

〔式中Ar', Ar' は置換基を有しても良いアリール 基または複素環基を表す。〕

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、各種表示装置の発光源として用いられる有機薄膜発光素子に係り、特に電子注入層あるいは発光層に用いられる物質に関する。

[0002]

【従来の技術】従来のブラウン管に代わるフラットディスプレイの需要の急増に伴い、各種表示素子の開発及び実用化が精力的に進められている。エレクトロルミネッセンス素子(以下EL素子とする)もこうしたニーズに 20即するものであり、特に全固体の自発発光素子として、他のディスプレイにはない高解像度及び高視認性により注目を集めている。

【0003】現在実用化されているものは、発光層に主に ZnS/Mn系を用いた無機材料からなるEL素子である。しかしながらこの種の無機EL素子は交流駆動であり、駆動電圧が200V程度以上と高いため、駆動方法が複雑となり製造コストが高い、また実用上十分な発光能を有する青色発光材料の開発が未だ見出されていないため、フルカラー化が困難であるなどの問題点を抱え30ている。

【0004】これに対して、有機材料を用いた有機発光素子は、発光に必要な駆動電圧が大幅に低減でき、かつ各種発光材料の適応によりフルカラー化の可能性を充分に持つことから、近年研究が活発化している(例えば米国特許3,530,325号、Mol. Cryst. Liq. Cryst., 135,355(1986))。その中でも発光効率を向上させる目的で陽極/正孔注入層/発光層/負極からなる積層型の有機薄膜発光素子に、特定有機化合物からなる発光層と特定有機化合物からなる正孔注入層の積層薄膜を用40いて、10V以下の印加電圧で1,000cd/m²以上の輝度が得られたという報告(Appl.Phys.Lett.,51,913,(1987),特開昭57—51781号公報,特開昭59—194393号公報)がなされて以来、研究に拍車がかけられた。

【0005】また一層の性能向上を目指して、負極に用

いる金属材料を最適化した素子(特開昭63—264692号公報,特開平2—15595号公報),発光層として特定有機化合物からなるホスト材料中にレーザー色素をドープした素子(J. Appl. Phys., 65, 3610(1989),米国特許4,769,292号),特定有機化合物からなる電子注入層をさらに設けて陽極/正孔注入層/発光層/電子注入層/負極の積層型とした3原色の発光素子(Jpn. J. Appl. Phys., 27,4,713(1988))などの試みがなされている。

10 [0006]

【発明が解決しようとする課題】以上のように有機薄膜発光素子は高輝度発光,低電圧駆動,三原色発光などフルカラー表示デバイスの可能性を強く示唆しているものの、実用化には多くの課題が残されている。特に連続駆動時の特性劣化(詳しくは所謂ダークスポットの発生と成長に伴う表示品質の低下,輝度の経時変化)は解決せねばならない課題である。また他の表示方式と競合しうる消費電力、耐候性など諸性能の向上も課題として挙げられる。

【0007】これら諸問題の原因の一つとして、有機化合物を用いた薄膜の機械的熱的不安定性および光一電子的機能の不足が指摘されている(例えばIEICE Technical Report, OME-92-9(1992), 日本学振光電相互変換第125委第11回EL分科会資料,7(1994))。この発明は上述の点に鑑みてなされその目的は、薄膜状態での機械的熱的安定性に優れる上に、光電変換能や電荷注入性/輸送能の良好な有機物質を提供することにより、連続駆動時の特性劣化の少ない有機薄膜発光素子を提供することにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】上述の目的はこの発明によれば、下記一般式で表されるチアジアゾール系化合物を電子注入層または発光層に含有するとすることにより達成される。

[0009]

[化2]

【0010】〔式中Ar', Ar' は置換基を有しても良いアリール基または複素環基を表す。〕

一般式で表されるチアジアゾール系化合物の具体例がそれぞれ化学式(1)ないし化学式(91)に示される。

[0011]

[化3]

1

[0012]

【化4】

$$CH_3 - CH_3 -$$

$$+\bigcirc -\stackrel{\mathsf{N-N}}{\varsigma} -\bigcirc -\bigcirc \qquad (27) \qquad +\bigcirc -\stackrel{\mathsf{N-N}}{\varsigma} -\bigcirc -\mathsf{NO}_2 \qquad (28)$$

[0013]

【化5】

$$\bigcirc -\bigcirc -\stackrel{\text{N-N}}{\varsigma} - \stackrel{\text{N}}{\varsigma}) \qquad (41) \qquad \bigcirc -\bigcirc -\stackrel{\text{N-N}}{\varsigma} - \stackrel{\text{N}}{\varsigma} \qquad (42)$$

[0014]

9

$$O_2N \longrightarrow C_S^{N-N} \longrightarrow OC_2H_5 \quad (49) \qquad O_2N \longrightarrow C_S^{N-N} \longrightarrow S$$
 (50)

$$O_2N - O_3N -$$

$$O_2N$$
 O_2N O_2N O_2N O_2N O_3N O_3N

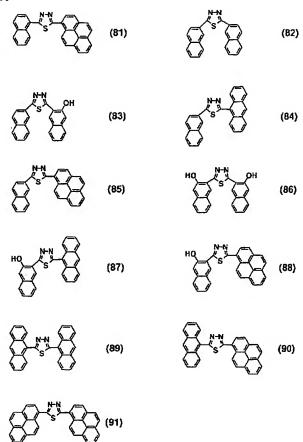
[0015]

[化7]

11

$$C_2N_5O \longrightarrow C_5N \longrightarrow C_5N$$

[0016]



【0017】一般式に示したチアジアゾール系化合物は、例えばヒドラジド化合物と酸クロライド化合物をピリジン還流下に反応させて前駆体を合成し、次いで得られた前駆体とLawesson試薬をトルエン還流下に反応させる二段階反応で合成され、一般的な分離精製手 30法によって容易に精製することができる。

[0018] 【化9]

【0019】一般式に示されるチアジアゾール系化合物は電子注入層に用いたときに陰極から発光層への電子注入性/輸送能を向上させる。一般式に示されるチアジアゾール系化合物は発光層に用いたときに電子注入性/輸送能を向上させる。この際に発光物質としても機能するものがある。またチアジアゾール系化合物は融点および結晶化点が高く(結晶化点は125℃以上,融点は255℃以上)、熱に起因する凝集や結晶化が生じにくい。【0020】

【発明の実施の形態】次にこの発明の実施例を図面に基づいて説明する。図1はこの発明の実施例に係る有機薄膜発光素子を示す断面図である。図2はこの発明の異なる実施例に係る有機薄膜発光素子を示す断面図である。図3はこの発明のさらに異なる実施例に係る有機薄膜発光素子を示す断面図である。

【0021】図4はこの発明のさらに異なる実施例に係る有機薄膜発光素子を示す断面図である。上図で1は基板、2は陽極、3は正孔注入層、4は発光層、5は電子注入層、6は陰極、7は封止層、8は電源である。基板1は有機薄膜発光素子の支持体であり、かつ発光を取り出す光学部材ともなるもので可視光に対して透明性が高いガラス、透明性樹脂等を用い、単一または複数の材料からなる積層体あるいは混合体、複合体であってもよ40い。

【0022】陽極2は効率良く正孔を注入し、低抵抗かつ可視光に対して透明性を有し、安定性が高いことが望ましい。陽極としては金属の半透膜,インジウムスズ酸化物(ITO),酸化スズ,酸化亜鉛などの透明導電膜やポリピロール,ポリチオフェンなどの導電性高分子を用い、単一または複数種の材料からなる積層体あるいは混合体、複合体であってもよい。陽極の形成方法は抵抗加熱蒸着,電子ビーム蒸着,スパッタ,ゾルゲル,イオンプレーティングまたはキャスティング,電解重合,化9重合法が用いられる。陽極の膜厚は、発光を取り出す

方向については透光性の見地から、発光波長領域での透 過率が80%以上となる範囲であることが望ましい。

【0023】正孔注入層3は正孔を効率良く輸送、注入 することが必要で、可視光に対して透明であることが望 ましい。正孔注入層には、イオン化ポテンシャルが大で あり、且つ光学的エネルギーギャップが大である有機化 合物、有機高分子化合物、無機高分子化合物等が用いら れ、これらの少なくとも一つを積層体あるいは混合体、 複合体として用いることができる。また正孔注入層には 薄膜安定性等の他の機能性を付与し強化する目的で、他 10 の化合物を含有せしめることもできる。正孔注入層の成 膜方法としては抵抗加熱蒸着, 分子線エピタキシー, ス ピンコート、キャスティング、LB法が用いられるが、 生産性の見地から抵抗加熱蒸着法あるいはスピンコート 法が好ましい。素子の動作電圧を下げる必要から正孔注 入層の電界が印加される方向の膜厚は 5nmないし 100nm の範囲であることが好ましい。

【0024】電子注入層5は電子を効率良く輸送、注入 することが必要で、可視光に対して透明であることが望 ましい。電子注入層にはイオン化ポテンシャルが大であ 20 り、且つ電子親和力が大である有機化合物、有機高分子 化合物、無機高分子化合物等が用いられ、これらの少な くとも一つを積層体あるいは混合体、複合体として用い ることができる。また電子注入層には薄膜安定性等の他 の機能性を付与し強化する目的で、他の化合物を含有せ しめることもできる。電子注入層の成膜方法としては抵 抗加熱蒸着,分子線エピタキシー,スピンコート,キャ スティング、LB法が用いられるが、生産性の見地から 抵抗加熱蒸着法あるいはスピンコート法が好ましい。素 子の動作電圧を下げる必要から、電子注入層の電界が印 30 加される方向の膜厚は 5nmないし 100nmの範囲であるこ とが好ましい。

【0025】発光層4は正孔注入層3または陽極2から 注入される正孔と、陰極6または電子注入層5から注入 される電子との再結合により効率良く発光することが望 ましい。発光層は、可視領域に発光帯をする必要があ り、一般的には近紫外から可視領域に蛍光帯を有しかつ 高い蛍光量子効率を有する有機化合物、有機高分子化合 物、無機高分子化合物等が用いられ、これらの少なくと とができる。また電子注入層には薄膜安定性等の他の機 能性を付与し強化する目的で、他の化合物を含有せしめ ることもできる。

【0026】特に上述の正孔注入層もしくは電子注入層 に用いられる化合物の少なくとも一つを発光層に含有せ しめるか、または上述の正孔注入性能または電子注入性 能の電荷注入性能と発光性能を具備する物質を発光層に 含有せしめることで、電荷注入性の良好な発光層とする ことも可能である。発光層の成膜方法としては抵抗加熱 蒸着、分子線エピタキシー、スピンコート、キャスティ 50 該容器を封じ切って最終封止をおこなった。

ング、LB法などが用いられるが、生産性の見地から抵 抗加熱蒸着法またはスピンコート法が好ましい。素子の 動作電圧を下げる必要から、正孔注入層の電界が印加さ れる方向の膜厚は 5nmないし 100nmの範囲であることが 好ましい。

【0027】陰極6は電子を効率良く有機層に注入する ことが必要である。陰極6としては仕事関数の小さいM g, Ag, In, Ca, Sc, Al等およびこれらの合 金、複合体、積層体が用いられる。陰極の成膜方法とし ては抵抗加熱蒸着、電子ビーム蒸着、スパッタ、イオン プレーティング法などが用いられる。封止層7は有機薄 膜発光素子の最外層に位置し、素子への外部からの酸 素、水分等の侵入を防止し、かつ陰極6の破損、剥離を 抑制するための補強構造として機能する。封止層は、疎 水性かつ酸素、水の透過性が低い薄膜を形成する有機化 合物, 有機高分子化合物, 無機高分子化合物, 金属酸化 物、金属、無機非晶質の少なくとも一つを積層体あるい は混合体、複合体の形で用いる事ができる。封止層の形 成方法としては抵抗加熱蒸着、分子線エピタキシー、ス ピンコート、キャスティング、LB、キャン封止法など が用いられるが、陰極6の酸化あるいは積層素子のガス 吸収を最小限に抑える必要があるため、少なくとも1層 以上の封止層を、陰極6の成膜直後に真空を破ることな く連続して成膜することが好ましい。

[0028]

【実施例】

実施例1

図1はこの発明の実施例に係る有機薄膜発光素子を示す 断面図である。膜厚1,000ÅのITOパターンを陽 極2として設けた50mm角のガラス(NA45:NH テクノグラス製) 基板1を洗浄した後、抵抗加熱蒸着装 置内の基板ホルダーに装着し約10°Paまで真空排気 した後、150℃で2時間の基板ベーキングを行った。 その後基板を50℃まで冷却し、温度と真空度を安定さ せて成膜を開始した。

【0029】発光層4として化学式IIに示すジアミン化 合物を、抵抗加熱式蒸発源にて加熱し、成膜速度を約3 A/秒として500A厚さに形成した。続いて電子注入 層5として化学式14に示すチアジアゾール系化合物を も一つを積層体あるいは混合体、複合体として用いるこ 40 抵抗加熱式蒸発源にて加熱し、成膜速度を約1A/秒と して400Å厚さに形成した。さらに続いて陰極6とし てMgIn合金(In含有率約5体積%)を共蒸着法に より2,000Å厚さに形成した。さらに続いて封止層 7としてフッ素樹脂をガラスウールに含浸させた試料 を、抵抗加熱式蒸発源にて加熱し、成膜速度を約20Å /秒として5,000Å厚さに形成した。以上の全成膜 工程は、5×10¹Pa以下の真空を維持して連続して 行った。以上の方法で作製された積層試料を給電線を配 したガラス容器内に装着し、窒素ガスで置換したのちに

17

【0031】実施例2

電子注入層として化学式26に示したチアジアゾール系 化合物を用いる他は実施例1と同様にして有機薄膜発光 10 素子を作製した。

実施例3

電子注入層として化学式29に示したチアジアゾール系 化合物を用いる他は実施例1と同様にして有機薄膜発光 素子を作製した。

実施例4

電子注入層として化学式 7 7 に示したチアジアゾール系 化合物を用いる他は実施例 1 と同様にして有機薄膜発光 索子を作製した。

【0032】実施例1~4に従って作製した有機薄膜発光素子を直流電源に接続し、初期輝度を100cd/m²として500時間の連続駆動試験を実施した。各素子の発光色と、該試験開始時の輝度に対する終了時の輝度の保持率、および素子面積4mm²に対する非発光欠陥部(所謂ダークスポット)の面積率を表1に示す。

[0033]

【表1】

拭 料	発光色	輝度保持率(%)	非発光欠陷部面積率(%)
実施例1	緑色	5 0	2
実施例 2	森色	6 3	< 1
実施例3	舞色	5 8	. <1
実施例 4	森色	5 2	3

【0034】発光スペクトルから得られた有機薄膜発光素子の発光は化学式IIに示すジアミン化合物に由来することが確認された。以上の結果から化学式IIに示すジアミン化合物は正孔注入性発光物質として機能していること、電子注入層5に用いたチアジアゾール系化合物は有機薄膜発光素子の薄膜安定性と電子注入性を良好にしていることがわかる。

実施例5

図2はこの発明の異なる実施例に係る有機薄膜発光素子 30 を示す断面図である。

【0035】 膜厚1,000ÅのITOパターンを陽極2として設けた5.0mm角のガラス (NA45:NHテクノグラス製) 基板1を洗浄した後、抵抗加熱蒸着装置内の基板ホルダーに装着し約 10^{-6} Paまで真空排気した後、150 ℃で2時間の基板ベーキングを行った。その後基板を50 ℃まで冷却し、温度と真空度を安定させて成膜を開始した。

【0036】正孔注入層3として化学式III に示すシアミン化合物を抵抗加熱式蒸発源にて加熱し、成膜速度を約3A/秒として500A厚さに形成した。続いて発光層4として化学式32に示したチアシアゾール系化合物を抵抗加熱式蒸発源にて加熱し、成膜速度を約1A/秒として400A厚さに形成した。さらに続けて陰極6としてMgIn合金(In含有率約5体積%)を共蒸着法により2,000A厚さに形成した。さらに続けて封止層7としてフッ案樹脂をガラスウールに含浸させた試料を抵抗加熱式蒸発源にて加熱し、成膜速度を約20A/秒として5,000A厚さに形成した。以上の全成膜工程は、5×10・Pa以下の真空を維持して連続して行50

った。以上のようにして作製された積層試料を給電線を 配したガラス容器内に装着し、窒素ガスで置換したのち に該容器を封じ切って最終封止をおこなった。

[0037]

【化11】

【0038】実施例6

発光層4として化学式37に示したチアジアゾール系化合物を用いる他は実施例5と同様にして有機薄膜発光素子を作製した。

実施例7

発光層4として化学式47に示したチアジアゾール系化 合物を用いる他は実施例5と同様にして有機薄膜発光素 子を作製した。

実施例8

6 発光層4として化学式79に示したチアジアソール系化 合物を用いる他は実施例5と同様にして有機薄膜発光素 子を作製した。

【0039】実施例5~8に従って作製した有機薄膜発光素子を直流電源に接続し、初期輝度を100cd/m として500時間の連続駆動試験を実施した。各素子の発光色と該試験開始時の輝度に対する終了時の輝度の保持率および素子面積4mm'に対する非発光欠陥部(所謂ダークスポット)の面積率を表2に示す。

.

[0040]

【表2】

Ħ	料	発光色	輝度保持率(%)	非発光欠陷部面積率(%)
突施例	5	育緑色	5 0	< 1
突施例	6	青色	5 3	< 1
突旋列	7	緑色	5 9	2
実施例	8	緑色	4 8	3

【0041】発光スペクトルから得られた有機薄膜発光 素子の発光はチアジアゾール系化合物に由来することが 確認された。以上の結果からチアジアゾール系化合物は 10 発光物質として機能していること、有機薄膜発光素子の 薄膜安定性と電子注入性を良好にしていることがわか る。

実施例9

図3はこの発明のさらに異なる実施例に係る有機薄膜発 光素子を示す断面図である。

【0042】膜厚1,000ÅのITOパターンを陽極 2として設けた50mm角のガラス(NA45:NHテ クノグラス製) 基板1を洗浄した後、抵抗加熱蒸着装置 内の基板ホルダーに装着し約10⁻¹ Paまで真空排気し 20 た後150℃で2時間の基板ベーキングを行った。その 後基板を50℃まで冷却し、温度と真空度を安定させて 成膜を開始した。

【0043】発光層4として化学式IIに示すジアミン化 合物と、化学式26に示すチアジアゾール系化合物をそ れぞれ別の抵抗加熱式蒸発源にて加熱し、成膜速度をそ れぞれ約3 Å/秒として同時共蒸着を行い、混合膜を8 00Å厚さに形成した。続いて陰極6としてMgIn合 金(In含有率約5体積%)を共蒸着法により2、00 素樹脂をガラスウールに含浸させた試料を抵抗加熱式蒸 発源にて加熱し、成膜速度を約20Å/秒として5,0 00Å厚さに形成した。以上の全成膜工程は、5×10

"Pa以下の真空を維持して連続して行った。以上のよ うにして作製された積層試料を給電線を配したガラス容 器内に装着し、窒素ガスで置換したのちに該容器を封じ 切って最終封止を行った。

実施例10

化学式26に示すチアジアゾール系化合物に替えて化学 式37に示すチアジアゾール系化合物を用いる他は実施 例9と同様にして有機薄膜発光素子を作製した。

実施例11

化学式26に示すチアジアゾール系化合物に替えて化学 式77に示すチアジアゾール系化合物を用いる他は実施 例9と同様にして有機薄膜発光素子を作製した。

比較例1

化学式11で示されるジアミン化合物を抵抗加熱式蒸発源 にて加熱し、成膜速度を約4人/秒として800人厚さ に形成して発光層4を形成する他は実施例9と同様にし て有機薄膜発光素子を作製した。

【0044】実施例9~11および比較例1に従って作 製した有機薄膜発光素子を直流電源に接続し、初期輝度 を100cd/m'として500時間の連続駆動試験を 実施した。各素子の発光色と該試験開始時の輝度に対す る終了時の輝度の保持率、ならびに素子面積4mm'に 0Å厚さに形成した。さらに続いて封止層7としてフッ 30 対する非発光欠陥部 (所謂ダークスポット) の面積率を 表3に示す。

[0045]

【表3】

試 料	発光色	輝度保持率(%)	非発光欠陷部面積率(%
実施例 9	森色	4 3	< 1
突施例10	400	4 0	2
実施例 1 1	绿色	4 9	< 1
比較例 1	緑色	(15) *	1.1

【0046】比較例1では最高輝度35cd/m'であ ったため、初期輝度25cd/m²として試験を実施し た。発光スペクトルから得られた有機薄膜発光素子の発 光は化学式11に示すジアミン化合物に由来することが確 認された。以上の結果から化学式川に示すジアミン化合 物は正孔注入性発光物質として機能していること、チア ジアゾール系化合物は比較例1との対比から有機薄膜発 光素子の薄膜安定性と電子注入性を良好にしていること がわかる。

[0047]

【発明の効果】この発明によれば一般式で表されるチア ジアゾール系化合物を有機薄膜発光素子の電子注入層ま たは発光層に含有するので、薄膜の機械的熱的安定性と ともに電子注入性/輸送能が向上し、連続駆動時に特性 劣化の少ない有機薄膜発光素子が得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の実施例に係る有機薄膜発光素子を示 50 す断面図

陽极 基板

22

【図2】この発明の異なる実施例に係る有機薄膜発光素 子を示す断面図

【図3】この発明のさらに異なる実施例に係る有機薄膜 発光素子を示す断面図

【図4】この発明のさらに異なる実施例に係る有機薄膜 発光素子を示す断面図

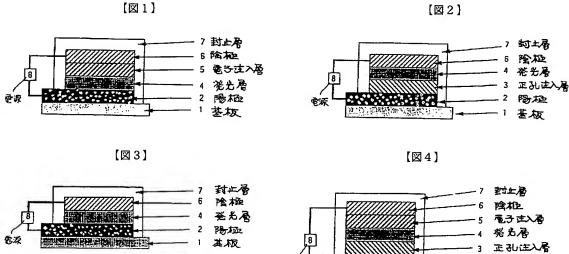
【符号の説明】

基板

2 陽極

- 正孔注入層
- 発光層
- 5 電子注入層
- 6 陰極
- 7 封止層
- 8 電源

[図2]



フロントページの続き

(72)発明者 川上 春雄

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機株式会社内